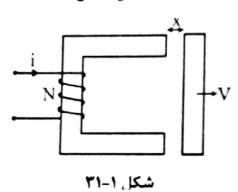
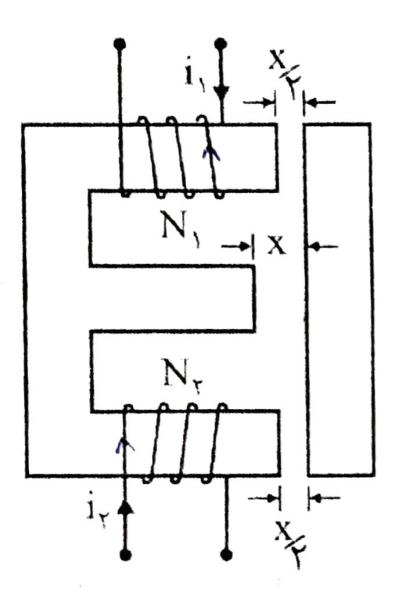
مثال I-V- در سیستم الکترومغناطیسی شکل زیر هسته و سیمپیچ ایده آل فرض می شوند. قطعه متحرک با سرعت ثابت V به سمت راست حرکت میکند. از سیمپیچ جریان ثابت V عبور میکند. ولتا القاء شده در سیمپیچ را بصورت تابعی از V V V (سطح مقطع هسته) و V بدست آورید.



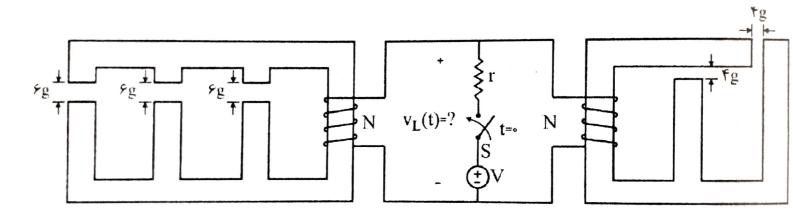
بنسبت $\frac{L_{17}}{L_{11}}$ کدام است؟



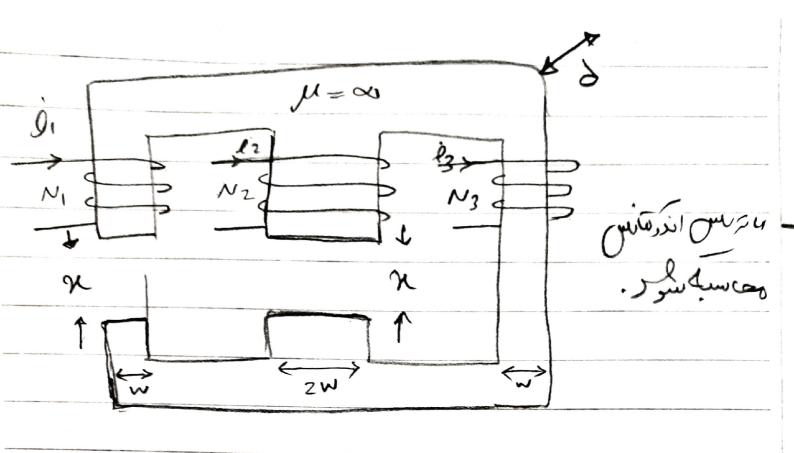
شکل ۱-۳۰

در مدار الکتریکی - مغناطیسی شکل زیر هستهها از جنس فرومغناطیس با ضبریب نفوذپذیری مغناطیسی نامحدود میباشند. سطح مقطع هر دو هسته برابر A میباشد. باقی اطلاعات مورد نیاز بر روی مدار مشخص شده است. حال مطلویست:

- الف) اگر منبع ${f V}$ یک منبع ${f dc}$ باشد، معادله زمانی ولتاژ دو سر سلفها را پس از بسته شدن کلید ${f S}$ بیابید.
- ب) اگر منبع ${f V}$ یک منبع سینوسی بصورت ${f V}_{m} \sin \omega t$ باشد، آنگاه بعد از طی شدن حالتگذاری مدار در اثر کلیدزنی، ولتاژ حالت دائمی دو سر سلفها را بیابید.



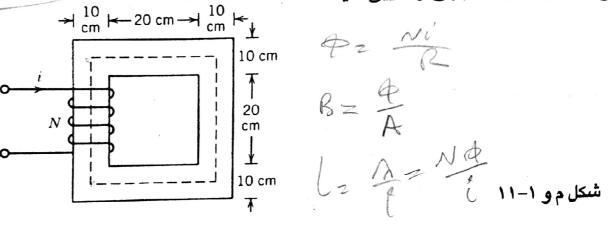
 $V_{
m m}$ sin ω t



۱۱-۱ مدار مغناطیسی شکل (م و ۱-۱۱) هسته ای با ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نسبی ۲۰۰۰ هسته ای با ضریب عمق هسته ۵ سانتی متر است. سیم پیچ حاوی ۴۰۰ دور می باشد و جریانی معادل ۱/۵ آمپر را حمل می کند.

R= MA Sloxa

الف: مدار معادل مغناطیسی را رسم کنید. ب: شار و چگالی شار در هسته را بیابید. ج: اندوکتانس سیم پیچ را تعیین کنید.



۱۲-۱ مسئله ۱-۱۱ را برای شکاف هوایی هسته به پهنای ۱ سانتی متر تکرار کنید. به دلیل پدیده خمیدگی

در شکاف هوایی ۱۰٪ افزایش را در مساحت سطح مقطع مؤثر شکاف هوایی را در نظر بگیرید.

الف. طول شکاف هوایی g و تعداد دور N را برای دستیابی به القاکنایی ۱٫۴ mH تعیین کنید، به نحوی که القاگر بتواند بدون اشباع شدن با جریان A کار کند. فرض کنید هسته در صورتی اشباع می شود که دامنهٔ چگالی شار در هسته به A ۱٫۷ A بر سد و در زیر اشباع تراوایی μ ۳۲۰۰ ست.

